

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the Application of

Norikazu OTA et al.

Application No.: 10/764,460



Group Art Unit: 2652

Filed: January 27, 2004

Docket No.: 118437

For: HEAD SLIDER, HEAD GIMBAL ASSEMBLY, AND HARD DISK DRIVE

CLAIM FOR PRIORITY

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application filed in the following foreign country is hereby requested for the above-identified patent application and the priority provided in 35 U.S.C. §119 is hereby claimed:

2003-024621 filed January 31, 2003 in Japan

In support of this claim, a certified copy of said original foreign application:

is filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the requirements of 35 U.S.C. §119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of this document.

Respectfully submitted,

James A. Oliff
Registration No. 27,075

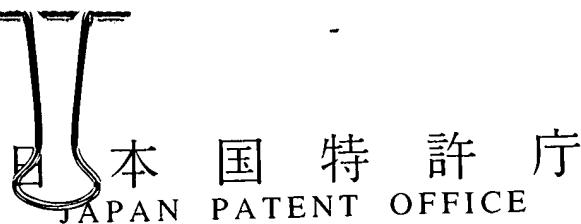
Joel S. Armstrong
Registration No. 36,430

JAO:JSA/mdw

Date: August 13, 2004

OLIFF & BERRIDGE, PLC
P.O. Box 19928
Alexandria, Virginia 22320
Telephone: (703) 836-6400

<p>DEPOSIT ACCOUNT USE AUTHORIZATION Please grant any extension necessary for entry; Charge any fee due to our Deposit Account No. 15-0461</p>
--



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
る事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日 2003年 1月31日
Date of Application:

出願番号 特願2003-024621
Application Number:
〔T. 10/C〕 [JP2003-024621]

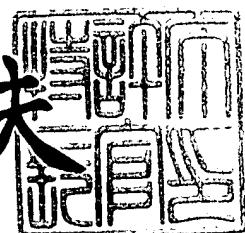
出願人 TDK株式会社
Applicant(s):

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2004年 1月 6日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井 康夫



【書類名】 特許願
【整理番号】 99P04808
【提出日】 平成15年 1月31日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 G11B 5/31
【発明者】
【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内
【氏名】 太田 憲和
【発明者】
【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内
【氏名】 佐々木 徹郎
【発明者】
【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内
【氏名】 大山 信也
【発明者】
【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内
【氏名】 小出 宗司
【特許出願人】
【識別番号】 000003067
【氏名又は名称】 ティーディーケイ株式会社
【代理人】
【識別番号】 100088155
【弁理士】
【氏名又は名称】 長谷川 芳樹

【選任した代理人】

【識別番号】 100092657

【弁理士】

【氏名又は名称】 寺崎 史朗

【選任した代理人】

【識別番号】 100108213

【弁理士】

【氏名又は名称】 阿部 豊隆

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014708

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ヘッドスライダ、ヘッドジンバルアセンブリ及びハードディスク装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 再生用の磁気抵抗効果素子と、書込用の誘導型電磁変換素子と、通電されることにより発熱するヒータと、を備えた薄膜磁気ヘッドを有し、前記磁気抵抗効果素子に通電するための第1素子用電極パッドと、前記誘導型電磁変換素子に通電するための第2素子用電極パッドと、前記ヒータに通電するためのヒータ用電極パッドとを同一面に備え、

前記ヒータ用電極パッドは、前記第1及び第2素子用電極パッドの群の両側に位置していることを特徴とするヘッドスライダ。

【請求項 2】 薄膜磁気ヘッドが形成されたヘッドスライダと、前記ヘッドスライダが搭載されるアームとを備えたヘッドジンバルアセンブリであって、

前記薄膜磁気ヘッドは、再生用の磁気抵抗効果素子と、書込用の誘導型電磁変換素子と、通電されることにより発熱するヒータと、を備え、

前記ヘッドスライダは、前記磁気抵抗効果素子に通電するための第1素子用電極パッドと、前記誘導型電磁変換素子に通電するための第2素子用電極パッドと、前記ヒータに通電するためのヒータ用電極パッドとを同一面に備え、

前記ヒータ用電極パッドは、前記第1及び第2素子用電極パッドの群の両側に位置していることを特徴とするヘッドジンバルアセンブリ。

【請求項 3】 前記第1素子用電極パッド、前記第2素子用電極パッド及び前記ヒータ用電極パッドに接続される通電用の配線は、前記電極パッドが備えられた面から折り返され、前記ヘッドスライダの周囲を回り込んで前記アームの基端側へ伸長しており、

前記電極パッドが備えられた面と前記アームの基端との間の領域において、前記ヒータ用電極パッドの配線が、前記第1素子用電極パッドの配線と前記第2素子用電極パッドの配線との間に位置していることを特徴とする請求項2記載のヘッドジンバルアセンブリ。

【請求項 4】 薄膜磁気ヘッドが形成されたヘッドスライダと、前記ヘッド

スライダが搭載されるアームとを備えたヘッドジンバルアセンブリを有するハードディスク装置であって、

前記薄膜磁気ヘッドは、再生用の磁気抵抗効果素子と、書込用の誘導型電磁変換素子と、通電されることにより発熱するヒータと、を備え、

前記ヘッドスライダは、前記磁気抵抗効果素子に通電するための第1素子用電極パッドと、前記誘導型電磁変換素子に通電するための第2素子用電極パッドと、前記ヒータに通電するためのヒータ用電極パッドとを同一面に備え、

前記ヒータ用電極パッドは、前記第1及び第2素子用電極パッドの群の両側に位置していることを特徴とするハードディスク装置。

【請求項5】 前記第1素子用電極パッド、前記第2素子用電極パッド及び前記ヒータ用電極パッドに接続される通電用の配線は、前記電極パッドが備えられた面から折り返され、前記ヘッドスライダの周囲を回り込んで前記アームの基端側へ伸長しており、

前記電極パッドが備えられた面と前記アームの基端との間の領域において、前記ヒータ用電極パッドの配線が、前記第1素子用電極パッドの配線と前記第2素子用電極パッドの配線との間に位置していることを特徴とする請求項4記載のハードディスク装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、磁気抵抗効果素子と誘導型電磁変換素子とを備えた薄膜磁気ヘッドを有するヘッドスライダ、ヘッドジンバルアセンブリ及びハードディスク装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

一般に、ヘッドジンバルアセンブリは、薄膜磁気ヘッドが形成されたヘッドスライダをサスペンションに接続されたジンバルに搭載して構成される。ヘッドスライダにおけるジンバルの先端側に位置する面には、薄膜磁気ヘッドに備えられた再生用の磁気抵抗効果素子と書込用の誘導型電磁変換素子とに通電するための

複数の電極パッドが設けられている（例えば、特許文献1参照。）。

【0003】

上記の電極パッドには、電気信号を入出力するための配線の一端が接続されている。この配線は、ヘッドスライダの周囲のジンバル上を這ってサスペンションの基端まで伸長しており、他端が磁気ディスクドライブ装置の信号端子に接続されている。再生用の磁気抵抗効果素子の配線には、一定の電流（センス電流）が常時供給されている。

【0004】

【特許文献1】

特開平8-111015号公報

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記従来のヘッドジンバルアセンブリでは、磁気抵抗効果素子の配線と誘導型電磁変換素子の配線とがジンバル上で並列に這わされているため、誘導型電磁変換素子の配線に電流を供給した場合、磁気抵抗効果素子の配線にノイズが乗る現象、すなわちクロストークを引き起こしてしまう虞がある。

【0006】

本発明の目的は、磁気抵抗効果素子の配線と誘導型電磁変換素子の配線との間におけるクロストークを防止することができるヘッドスライダ、ヘッドジンバルアセンブリ及びハードディスク装置を提供することである。

【0007】

【課題を解決するための手段】

本発明のヘッドスライダは、再生用の磁気抵抗効果素子と、書込用の誘導型電磁変換素子と、通電されることにより発熱するヒータと、を備えた薄膜磁気ヘッドを有し、磁気抵抗効果素子に通電するための第1素子用電極パッドと、誘導型電磁変換素子に通電するための第2素子用電極パッドと、ヒータに通電するためのヒータ用電極パッドとを同一面に備え、ヒータ用電極パッドは、第1及び第2素子用電極パッドの群の両側に位置していることを特徴とするものである。

【0008】

本発明のヘッドスライダは、同一面内において、ヒータ用電極パッドが、磁気抵抗効果素子用の第1素子用電極パッド及び誘導型電磁変換素子用の第2素子用電極パッドよりも外側に配されている。これらの電極パッドに接続される配線は、電極パッドが備えられた面から折り返されてヘッドスライダの周囲を回り込み、ヘッドスライダの後方へと這わされる。この際、2本のヒータの配線がスライダを挟むようにする。従って、ヒータ用電極パッドに接続された配線は、第1素子用電極パッドに接続された配線と第2誘導素子用電極パッドに接続された配線との間に位置することとなる。これにより、誘導型電磁変換素子の配線と磁気抵抗効果素子の配線との間がヒータの配線によって隔てられるため、誘導型電磁変換素子の配線に電流が供給された場合でも、磁気抵抗効果素子の配線へのクロストークを防止することができる。

【0009】

本発明は、薄膜磁気ヘッドが形成されたヘッドスライダと、ヘッドスライダが搭載されるアームとを備えたヘッドジンバルアセンブリであって、薄膜磁気ヘッドは、再生用の磁気抵抗効果素子と、書込用の誘導型電磁変換素子と、通電されることにより発熱するヒータと、を備え、ヘッドスライダは、磁気抵抗効果素子に通電するための第1素子用電極パッドと、誘導型電磁変換素子に通電するための第2素子用電極パッドと、ヒータに通電するためのヒータ用電極パッドとを同一面に備え、ヒータ用電極パッドは、第1及び第2素子用電極パッドの群の両側に位置していることを特徴とするものである。

【0010】

また、本発明のヘッドジンバルアセンブリでは、第1素子用電極パッド、第2素子用電極パッド及びヒータ用電極パッドに接続される通電用の配線は、電極パッドが備えられた面から折り返され、ヘッドスライダの周囲を回り込んでアームの基端側へ伸長しており、電極パッドが備えられた面とアームの基端との間の領域において、ヒータ用電極パッドの配線が、第1素子用電極パッドの配線と第2素子用電極パッドの配線との間に位置していることを特徴としている。

【0011】

本発明のヘッドジンバルアセンブリでは、ヘッドスライダの同一面内において

、ヒータ用電極パッドが、磁気抵抗効果素子用の第1素子用電極パッド及び誘導型電磁変換素子用の第2素子用電極パッドよりも外側に配されている。これらの電極パッドに接続される配線は、アームの先端側から折り返されてヘッドスライダの周囲を回り込み、アームの基端側へと這わされる。この際、2本のヒータの配線がスライダを挟むようにする。従って、ヒータ用電極パッドに接続された配線は、第1素子用電極パッドに接続された配線と第2誘導素子用電極パッドに接続された配線との間に位置することとなる。これにより、誘導型電磁変換素子の配線と磁気抵抗効果素子の配線との間がヒータの配線によって隔てられるため、誘導型電磁変換素子の配線に電流が供給された場合でも、磁気抵抗効果素子の配線へのクロストークを防止することができる。

【0012】

本発明は、薄膜磁気ヘッドが形成されたヘッドスライダと、ヘッドスライダが搭載されるアームとを備えたヘッドジンバルアセンブリを有するハードディスク装置であって、薄膜磁気ヘッドは、再生用の磁気抵抗効果素子と、書込用の誘導型電磁変換素子と、通電されることにより発熱するヒータと、を備え、ヘッドスライダは、磁気抵抗効果素子に通電するための第1素子用電極パッドと、誘導型電磁変換素子に通電するための第2素子用電極パッドと、ヒータに通電するためのヒータ用電極パッドとを同一面に備え、ヒータ用電極パッドは、第1及び第2素子用電極パッドの群の両側に位置していることを特徴とするものである。

【0013】

また、本発明のハードディスク装置では、第1素子用電極パッド、第2素子用電極パッド及びヒータ用電極パッドに接続される通電用の配線は、電極パッドが備えられた面から折り返され、ヘッドスライダの周囲を回り込んでアームの基端側へ伸長しており、電極パッドが備えられた面とアームの基端との間の領域において、ヒータ用電極パッドの配線が、第1素子用電極パッドの配線と第2素子用電極パッドの配線との間に位置していることを特徴としている。

【0014】

本発明のハードディスク装置では、ヘッドスライダの同一面内において、ヒータ用電極パッドが、磁気抵抗効果素子用の第1素子用電極パッド及び誘導型電磁

変換素子用の第2素子用電極パッドよりも外側に配されている。これらの電極パッドに接続される配線は、アームの先端側から折り返されてヘッドスライダの周囲を回り込み、アームの基端側へと這わされる。この際、2本のヒータの配線がスライダを挟むようにする。従って、ヒータ用電極パッドに接続された配線は、第1素子用電極パッドに接続された配線と第2素子用電極パッドに接続された配線との間に位置することとなる。これにより、誘導型電磁変換素子の配線と磁気抵抗効果素子の配線との間がヒータの配線によって隔てられるため、誘導型電磁変換素子の配線に電流が供給された場合でも、磁気抵抗効果素子の配線へのクロストークを防止することができる。

【0015】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。尚、同一要素には同一符号を用いるものとし、重複する説明は省略する。

【0016】

図1は、本実施形態のヘッドスライダを備えたハードディスク装置を示す図であり、図2は、図1に示すハードディスク装置に備えられ、薄膜磁気ヘッドが形成されたヘッドスライダを搭載したヘッドジンバルアセンブリの拡大斜視図である。ハードディスク装置1は、ヘッドジンバルアセンブリ（HGA：Head Gimbal Assembly）10を作動させて、高速回転するハードディスク2の記録面（図1の上面）に、薄膜磁気ヘッド11によって磁気情報を記録及び再生するものである。

【0017】

図2に示すように、ヘッドジンバルアセンブリ10は、金属製の薄板であるサスペンションアーム12を備えている。サスペンションアーム12の先端側には、切込みで囲われたタンク部14が形成されており、このタンク部14上に薄膜磁気ヘッド11が形成されたヘッドスライダ13が搭載されている。

【0018】

また、サスペンションアーム12上には、先端側に設けられた端子15a～15fと基端側に設けられた端子16a～16fとに接続される配線17a～17

cを絶縁層で被覆したプリント配線17が備えられている。配線17a～17cは、順に、後述するヒータ用電極パッド23a, 23b、記録用電極パッド21a, 21b、再生用電極パッド22a, 22bに電気的に接続される（図3参照）。

【0019】

プリント配線17は、端子15a～15fからヘッドスライダ13の周囲を回り込んでヘッドスライダ13の後方へと這わされ、端子16a～16fまで伸長している。このプリント配線17によって、ヘッドスライダ13に形成された薄膜磁気ヘッド11の各素子が端子15a～15fを介して通電されるようになっている。

【0020】

尚、ヘッドスライダ13、プリント配線17及び各端子15a～15f, 16a～16fは、絶縁層18を介してサスペンションアーム12上に配されており、金属製のサスペンションアーム12とは絶縁されている。

【0021】

以上のようなヘッドジンバルアセンブリ10は、図1に示すように、支軸3周りに例えばボイスコイルモータによって回転可能となっている。ヘッドジンバルアセンブリ10を回転させると、ヘッドスライダ13は、ハードディスク2の半径方向、すなわちトラックラインを横切る方向に移動する。

【0022】

図3は、図2に示すヘッドスライダ13の拡大図である。ヘッドスライダ13は、略直方体形状をなし、アルティック（Al₂O₃・TiC）からなる基台20上に、薄膜磁気ヘッド11が形成されている。尚、図では、薄膜磁気ヘッド11が、基台20の水平方向における中央付近に形成されているが、形成位置はこれには限定されない。

【0023】

図3におけるヘッドスライダ13の上面は、ハードディスク2の記録面に対向する記録媒体対向面であり、エアベアリング面（ABS:Air Bearing Surface）Sと称される。ハードディスク2が回転する際、この回転に伴う空気流によつ

てヘッドスライダ13が浮上し、エアベアリング面Sはハードディスク2の記録面から離隔する。尚、エアベアリング面Sは、DLC (Diamond Like Carbon)等のコーティングが施されていてもよい。

【0024】

図3におけるヘッドスライダ13の手前側の面には、薄膜磁気ヘッド11を保護するために、オーバーコート層21が設けられている。オーバーコート層21の表面には、記録用電極パッド21a, 21b、再生用電極パッド22a, 22b及びヒータ用電極パッド23a, 23bが取り付けられている。ヒータ用電極パッド23a, 23bは、記録用電極パッド21a, 21b及び再生用電極パッド22a, 22bからなる群の両側に位置している。ヒータの詳細は後述する。尚、図では、記録用電極パッド21a, 21bの右側に再生用電極パッド22a, 22bが取り付けられているが、左右反対に取り付けられていてもよい。

【0025】

記録用電極パッド21a, 21b、再生用電極パッド22a, 22b及びヒータ用電極パッド23a, 23bは、サスペンションアーム12に設けられた端子15a～15fにそれぞれ電気的に接続されている。本実施形態では、記録用電極パッド21a, 21bがそれぞれ端子15e, 15fに、再生用電極パッド22a, 22bがそれぞれ端子15a, 15bに、ヒータ用電極パッド23a, 23bがそれぞれ端子15d, 15cに電気的に接続されている。

【0026】

各電極パッドと端子15a～15fとの接続に際しては、例えば、ボンディングの材質として金を用いたボールボンディング（ゴールドボールボンディング；Gold Ball Bonding）が用いられる。

【0027】

更に、端子15a～15fには、上述した配線17a～17cが接続されている。本実施形態において、記録用電極パッド21a, 21bに電気的に接続された配線17b, 17bは、ヒータ用電極パッド23aに電気的に接続された配線17aと共に、各電極パッドが備えられた面から折り返されてヘッドスライダ13の周囲を回り込み、図2に示す端子16e, 16fに接続される。この場合、

配線17aは、端子16dに接続される。再生用電極パッド22a, 22bに電気的に接続された配線17c, 17cは、ヒータ用電極パッド23bに電気的に接続された配線17aと共に、配線17b, 17bとは反対の方向に折り返されてヘッドスライダ13の周囲を回り込み、図2に示す端子16a, 16bに接続される。この場合、配線17aは、端子16cに接続される。

【0028】

図4は、薄膜磁気ヘッド11におけるエアベアリング面Sに対して垂直な方向の概略断面図である。薄膜磁気ヘッド11は、基台20上に、再生用のGMR素子（磁気抵抗効果素子；Giant Magneto Resistive）30を有する再生ヘッド部31と、書込用の誘導型の電磁変換素子としての記録ヘッド部32とを積層した複合型薄膜磁気ヘッドとなっている。GMR素子は、磁気抵抗変化率が高い巨大磁気抵抗効果を利用したものである。

【0029】

記録ヘッド部32は、いわゆる面内記録方式を採用しており、下部磁極33と、GMR素子30との間に下部磁極33を挟むとともに下部磁極33に磁気的に連結された上部磁極34と、一部が下部磁極33と上部磁極34との間に位置する薄膜コイル35とを主として備えている。

【0030】

上部磁極34は、エアベアリング面S側に位置する磁極部分層34aと、これに接続されると共に薄膜コイル35の上方を迂回するヨーク部分層34bとから構成されている。

【0031】

また、GMR素子30におけるエアベアリング面Sとは反対側、すなわちエアベアリング面Sから見たGMR素子30の裏側には、Cu, NiFe, Ta, Ti, CoNiFe合金, FeAlSi合金等で形成されたヒータ40aが設けられている。このヒータ40aは、通電による発熱で周囲の層を熱膨張させ、GMR素子30とハードディスク2との間隔を調整するものである。

【0032】

ヒータ40aは、蛇行形状をしており、その両端には図中上方に伸びたCu等

の導電材料からなる2つの導電部41a, 41bが電気的に接続されている。該導電部41a, 41bの上端（オーバーコート層21の表面）にはそれぞれ上述したヒータ用電極パッド23a, 23bが取り付けられている。

【0033】

また同様に、再生ヘッド部31及び記録ヘッド部32に関しても、導電材料からなる2つの導電部（図示せず）が電気的に接続されており、導電部の上端において、それぞれ上述した再生用電極パッド22a, 22b、記録用電極パッド21a, 21bに接続されている。

【0034】

図5は、ヒータ40aの一例を示す平面図である。ヒータ40aは、一本のラインを蛇行させた構造となっており、ラインの両端にはそれぞれ引出し電極85a, 85bが接続されている。引出し電極85a, 85bは、それぞれ図4に示した導電部41a, 41bに接続されている。

【0035】

ヒータ40aの寸法については、例えば蛇行させるラインのピッチを3μmとし、ライン幅を2μm、隣り合うラインの間隔を1μmとする。ヒータ用電極パッド23a, 23b間に電圧を印加してヒータ40aに通電することで（例えば20mA程度の電流を流す）、ヒータ40aが発熱するようになっている。

【0036】

尚、導電部41a, 41b、ヒータ用電極パッド23a, 23b、記録用電極パッド21a, 21b及び再生用電極パッド22a, 22bは、図4の紙面に対し垂直な方向に並設されているため、図4では、ヒータ40aにおける導電部41a及びヒータ用電極パッド23aについてのみを示している。

【0037】

以上のように構成されたヘッドスライダ13は、図3に示すように、同一面内において、ヒータ用電極パッド23a, 23bが、記録用電極パッド21a, 21b及び再生用電極パッド22a, 22bよりも外側に配されている。

【0038】

これらの電極パッドに接続される配線17a～17cは、サスペンションアー

ム12の先端側から折り返されてヘッドライダ13の周囲を回り込み、サスペンションアーム12の基端側へと這わされている。

【0039】

このため、プリント配線17のうち、ヒータ用電極パッド23a, 23bに電気的に接続された配線17aは、各電極パッドが備えられた面とサスペンションアーム12の基端との間の領域において、記録用電極パッド21a, 21bに電気的に接続された一対の配線17bと再生用電極パッド22a, 22bに電気的に接続された一対の配線17cとの間に位置することとなる。

【0040】

従って、記録ヘッド部32の配線17bと再生ヘッド部31の配線17cとの間がヒータ40aの配線17aによって隔てられることとなり、記録ヘッド部32の配線17bに電流が供給された場合でも、再生ヘッド部31の配線17cにノイズが乗ることなく、すなわちクロストークが防止される。

【0041】

ここで、図4に示した薄膜磁気ヘッドの製造方法の一例を説明する。

【0042】

まず、アルティック ($Al_2O_3 \cdot TiC$) 等からなる基板38に、スパッタリング法によって、例えばアルミナ (Al_2O_3) 等の絶縁材料からなる下地層39を厚さ約 $1\ \mu m$ ～約 $10\ \mu m$ で形成する。基板38及び下地層39は、後にヘッドライダの基台20となるものである。

【0043】

次に、下部シールド層42上に、公知の手法によってGMR素子30を形成する。GMR素子30は、実際は複数の膜から構成されるが、図においては単層で示している。次に、下部シールド層42及びGMR素子30を覆うように、例えばスパッタリング法によって Al_2O_3 等からなる絶縁層44を形成する。尚、図4において、ここで積層された絶縁層と、下部シールド層42とを一体的に絶縁層44として示している。

【0044】

続いて、GMR素子30及び絶縁層44を覆うように、例えばめっき法によっ

て上部シールド層45を厚さ約1.0 μm ～約4.0 μm で形成する。また、上部シールド層45を形成するのと同時に、同じく絶縁層44上に、上部シールド層45の作製と同一の処理（例えめっき法）によってCu, NiFe, Ta, Ti, CoNiFe合金, FeAlSi合金等の導電性材料からなるヒータ40aを形成する。ヒータ40aの高さは、例えば上部シールド層45と同程度にする。上部シールド層45とヒータ40aを同一の材料にする場合は、両者を同時に形成できる。

【0045】

次に、上部シールド層45及びヒータ40a上に、例えばスパッタリング法によって、Al₂O₃等の絶縁材料からなる絶縁層46をヒータ40aが覆われる程度に厚く積層する。その後、この絶縁層46の表面を研磨して平坦にする。このとき、絶縁層46は、上部シールド層45上での厚さが約0.1 μm ～約0.5 μm であり、上部シールド層45の後方ではそれより厚くなっている。以上により、再生ヘッド部31が得られる。尚、絶縁層46を始めから約0.1 μm ～約0.5 μm で積層してもよく、この場合、絶縁層46を積層し、ヒータ40aの絶縁層46から突出した部分を覆うように、後述するオーバーコート層21を形成する。

【0046】

次いで、絶縁層46上に、パーマロイからなる下部磁極33を例えばスパッタリング法で形成する。そして、下部磁極33上に例えばスパッタリング法で非磁性層50を形成し、この非磁性層50上にフォトレジスト層51を形成する。また、非磁性層50には、フォトリソグラフィ及びドライエッティングによってコンタクトホール50hを形成する。

【0047】

更に、フォトレジスト層51上に、フォトリソグラフィ及びめっき法等を利用して一段目の薄膜コイル35を厚さ約1 μm ～約3 μm で形成した後、薄膜コイル35上にフォトレジスト層53を形成する。薄膜コイル35の一部は、下部磁極33と上部磁極34との間に位置する。

【0048】

1段目の薄膜コイル35を形成した後に、上部磁極34の磁極部分層34aを形成し、その後2段目の薄膜コイル35を形成する。その後、薄膜コイル35の中央部に相当する位置において非磁性層50をエッチングすることでコンタクトホール50hを形成し、上部磁極34の後側部分となるヨーク部分層34bを形成する。本実施形態では薄膜コイル35及びフォトレジスト層53は2段積層するが、段数や形成手順はこれに限られない。

【0049】

次に、上部磁極34を覆うように、オーバーコート層21を形成する。尚、図4に示した導電部41a, 41bは、概略以下の手法により形成することができる。すなわち、ヒータ40a及び引出し電極85a, 85b(図5参照)を形成した後に、引出し電極85a, 85bがその後の積層材料で覆われないようにレジストパターンを形成する。そして、例えばオーバーコート層21を形成した後に、このレジストパターンをリフトオフする。次いで、例えばフレームめつき法によって導電部41a, 41bを形成し、これらの上端部にヒータ用電極パッド23a, 23bを配設する。

【0050】

また、再生ヘッド部31及び記録ヘッド部32に関しても、ヒータ40aと同様に導電部を形成し、図3に示すように、記録用電極パッド21a, 21b及び再生用電極パッド22a, 22bを、ヒータ用電極パッド23a, 23bと共にヘッドスライダ13の同一面上に配設する。

【0051】

以上により、記録ヘッド部32が得られ、本実施形態の薄膜磁気ヘッド11が完成する。

【0052】

ここで、ヒータの設置位置の他の形態について説明する。

【0053】

図6は、ヒータの設置位置の他の形態を示す図である。同図に示すように、ヒータは、例えば、基板38とGMR素子30との間に位置する層に設けてもよいし(図6中の二点鎖線で示すヒータ40b)、記録ヘッド部32の上方に設けて

もよい（図6中の二点鎖線で示すヒータ40c）。

【0054】

ヒータ40cの位置にヒータを設ける場合は、まず、オーバーコート層21の上にヒータ40cを形成し、次いで、例えばスパッタリング法によって、Al₂O₃等の絶縁材料からなるオーバーコート層52を更に形成する。

【0055】

また、ヒータは、上述した位置に一つだけ配置してもよいし、2つに分割して配置してもよい。図7は、ヒータが分割して配置された薄膜磁気ヘッド11の一例を示す概略断面図である。同図において、分割配置されたヒータ60は、図6に示すオーバーコート層52内に設けられたヒータ40cと同じ高さ位置に配されている。同図では、ヒータ40cの高さ位置での分割配置を示しているが、図6に示すヒータ40a, 40bの高さ位置で分割配置してももちろんよく、高さ位置は限定されない。

【0056】

上述したようにして薄膜磁気ヘッド11が完成したとき、薄膜磁気ヘッド11は、一枚の基板38上に複数形成された状態となっている。この状態から図3に示すヘッドライダ13を得るために、まず、基板38を切断して薄膜磁気ヘッド11が列状に配置された複数本のバーとし、更に、そのバーを切断して、それぞれが薄膜磁気ヘッド11を有するブロック単位に切断する。その後、所望のスライダレールを形成し（図示せず）、イオンミリング等を施し、ヘッドライダ13が完成する。

【0057】

また、このヘッドライダ13をサスペンションアーム12の先端側に搭載し、ヘッドライダ13に電気的に接続する配線17a～17cをサスペンションアーム12上に這わせ、配線17a～17cの一端をサスペンションアーム12の先端側に設けられた端子15a～15fにボンディングし、他端をサスペンションアーム12の基端側に設けられた端子16a～16fにボンディングすることによってヘッドジンバルアセンブリ10を作製することができる。ヘッドジンバルアセンブリ10を作製した後、ヘッドライダ13がハードディスク2上を

移動可能で、且つ、磁気信号の記録及び再生が可能となるように組み立てることで、図1に示したハードディスク装置1が完成する。

【0058】

以上、本発明を実施形態に基づき具体的に説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。例えば、第2の磁極を磁極部分層とヨーク部分層とに分けて、一体にしてもよい。また、薄膜磁気ヘッドを面内記録方式ではなく、垂直記録方式としてもよい。更に、再生ヘッド部において、GMR素子の代わりに、異方性磁気抵抗効果を利用するAMR(Anisotropy Magneto Resistive)素子、トンネル接合で生じる磁気抵抗効果を利用するTMR(Tunnel-type Magnet o Resistive)素子等を利用してもよい。

【0059】

【発明の効果】

本発明によれば、ヘッドスライダの同一面内において、ヒータ用電極パッドが第1及び第2素子用電極パッドの群の両側に位置しているため、磁気抵抗効果素子の配線と誘導型電磁変換素子の配線との間におけるクロストークを防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

実施形態に係るヘッドスライダを備えたハードディスク装置を示す図である。

【図2】

図1に示すハードディスク装置に備えられ、薄膜磁気ヘッドが形成されたヘッドスライダを搭載したヘッドジンバルアセンブリを示す拡大斜視図である。

【図3】

図2に示すヘッドスライダの拡大図である。

【図4】

薄膜磁気ヘッドにおけるエアベアリング面に対して垂直な方向の概略断面図である。

【図5】

ヒータ40aの一例を示す平面図である。

【図6】

ヒータの設置位置の他の形態を示す図である。

【図7】

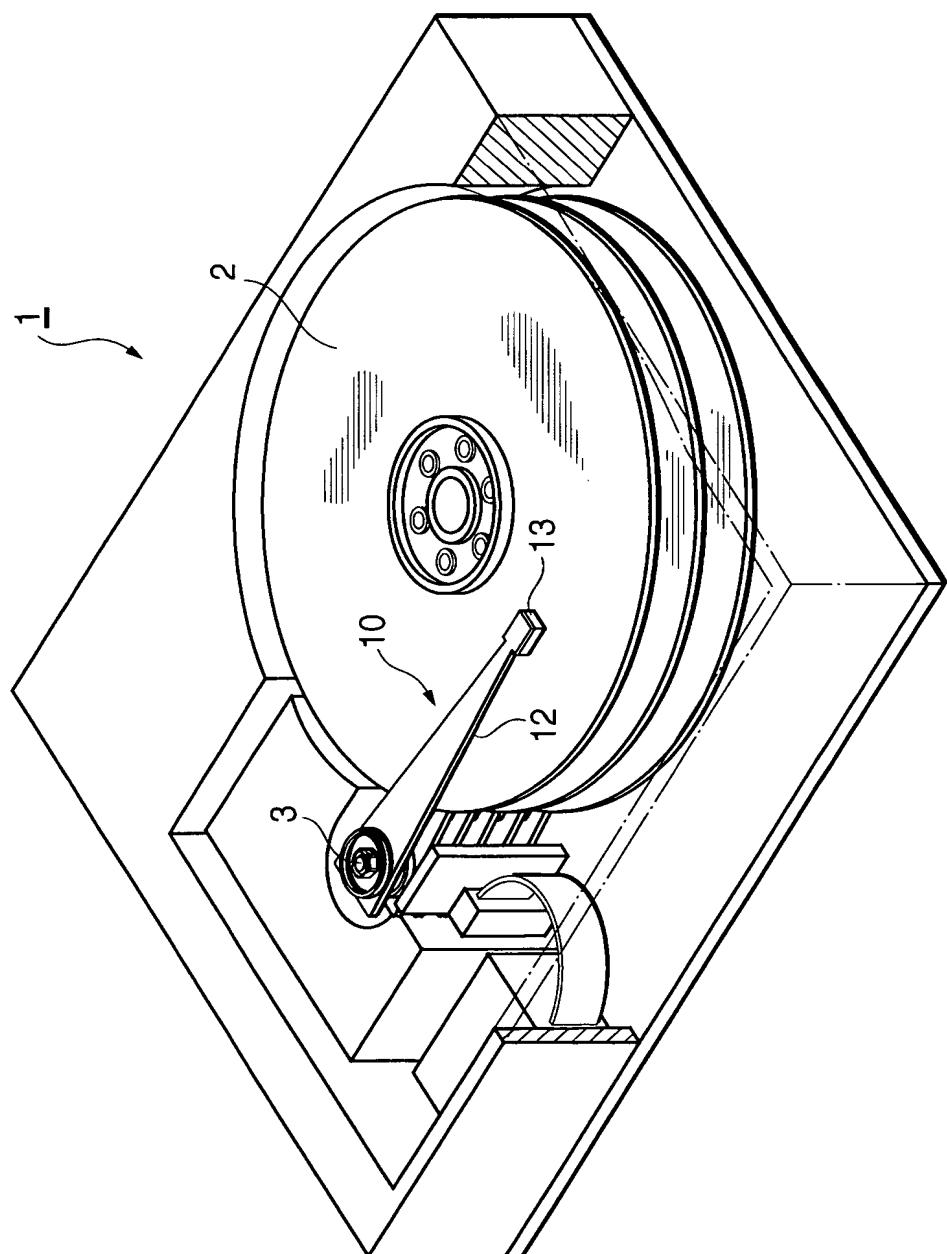
ヒータが分割して配置された薄膜磁気ヘッドの一例を示す概略断面図である。

【符号の説明】

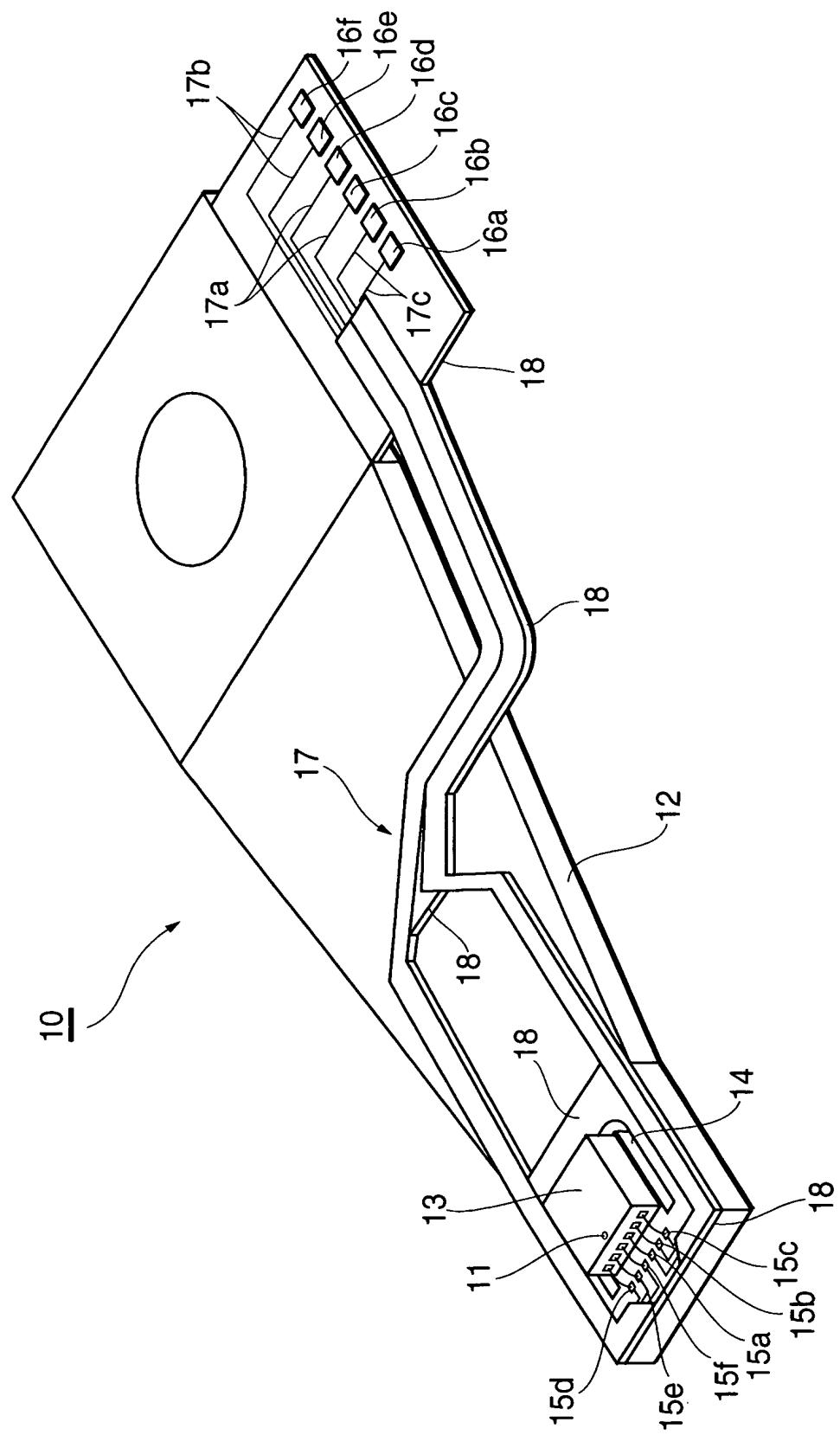
1…ハードディスク装置、2…ハードディスク、3…支軸、10…ヘッドジンバルアセンブリ、11…薄膜磁気ヘッド、12…サスペンションアーム、13…ヘッドスライダ、14…タンク部、15a～15f、16a～16f…端子、17…プリント配線、17a、17b、17c…配線、18…絶縁層、20…基台、21…オーバーコート層、21a、21b…記録用電極パッド（第2素子用電極パッド）、22a、22b…再生用電極パッド（第1素子用電極パッド）、23a、23b…ヒータ用電極パッド、31…再生ヘッド部、32…記録ヘッド部、33…下部磁極、34…上部磁極、34a…磁極部分層、34b…ヨーク部分層、35…薄膜コイル、38…基板、39…下地層、40a、40b、40c…ヒータ、41a、41b…導電部、42…下部シールド層、44…絶縁層、45…上部シールド層、46…絶縁層、50h…コンタクトホール、50…非磁性層、51…フォトレジスト層、52…オーバーコート層、53…フォトレジスト層、60…ヒータ、85a、85b…引出し電極、S…エアベアリング面（記録媒体対向面）。

【書類名】 図面

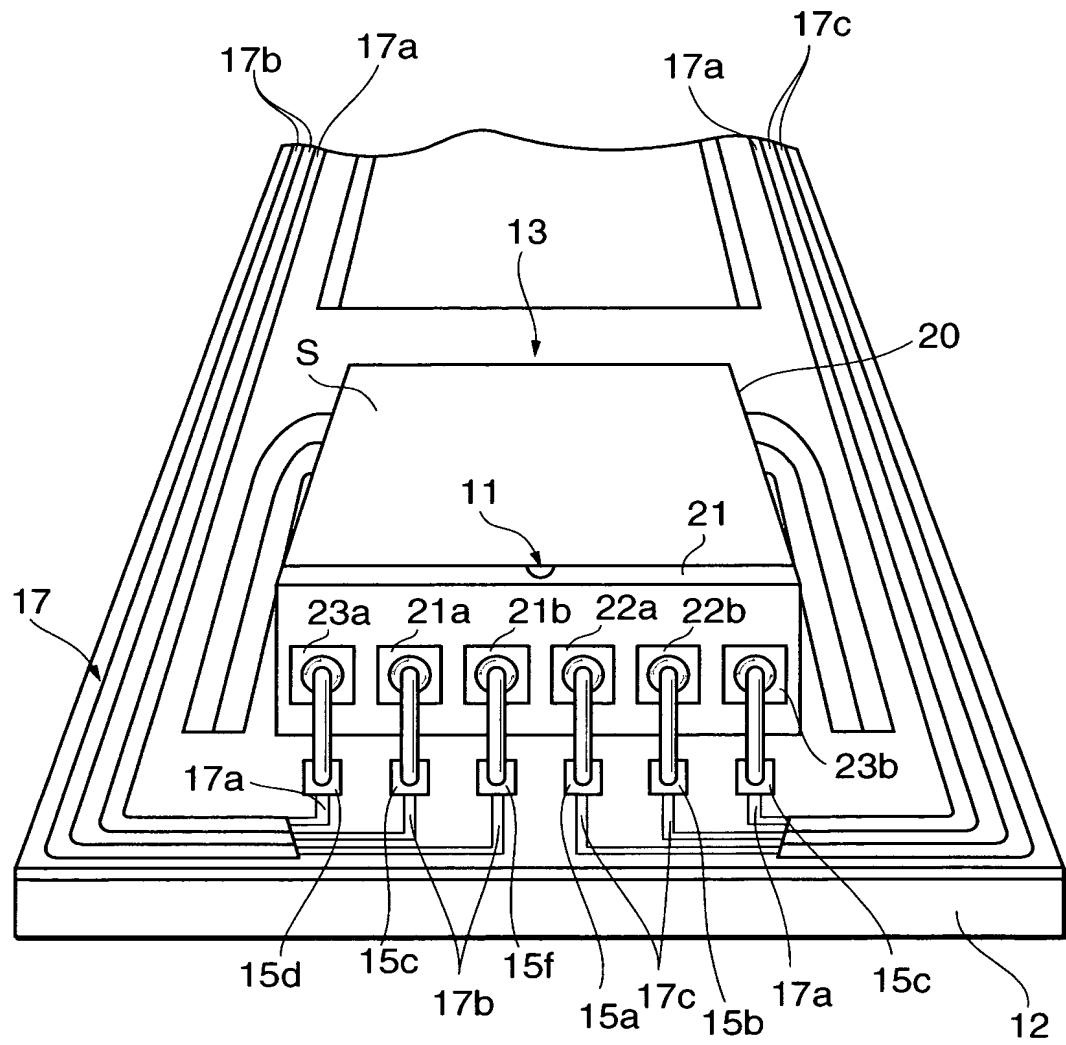
【図 1】



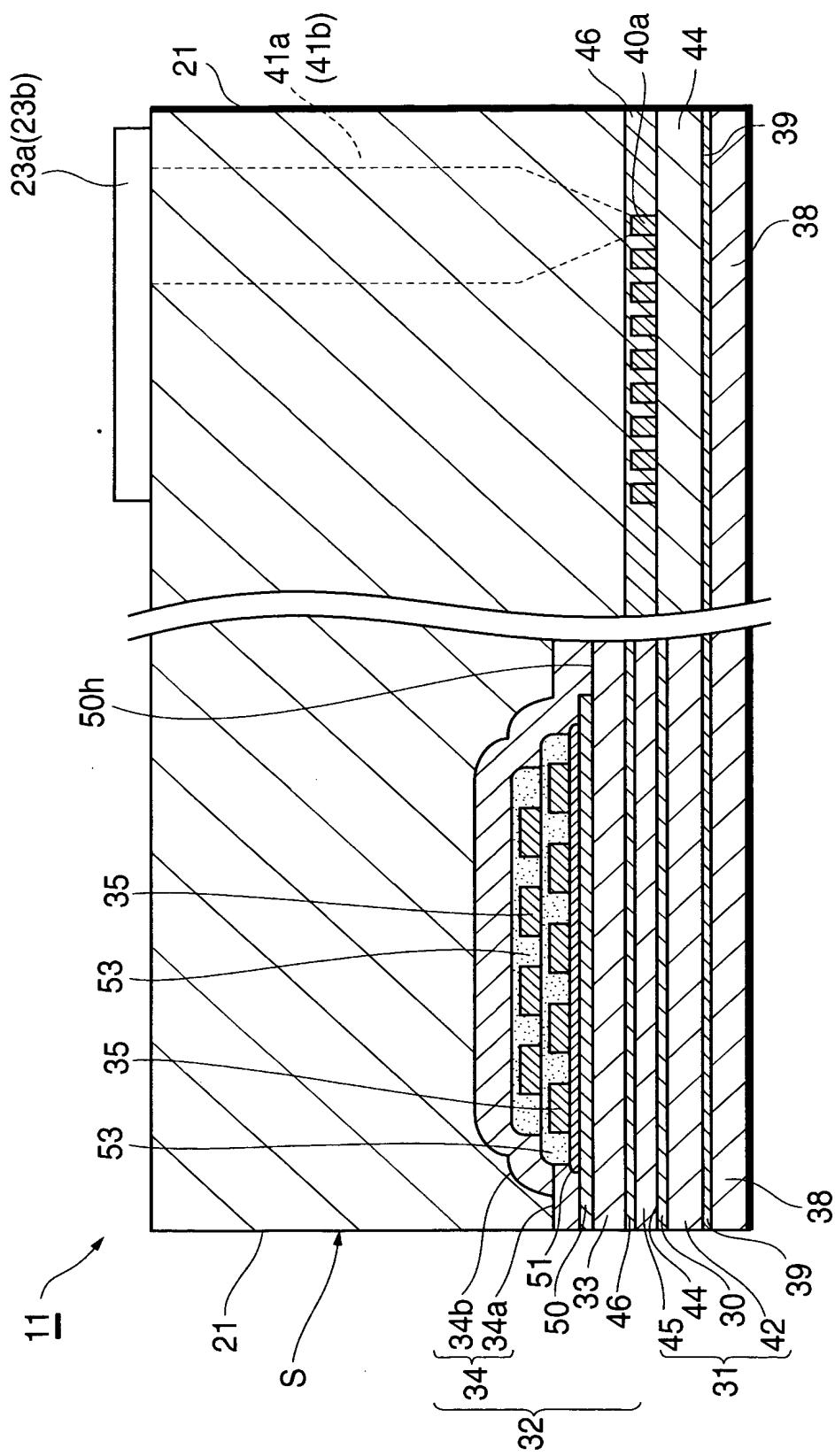
【図2】



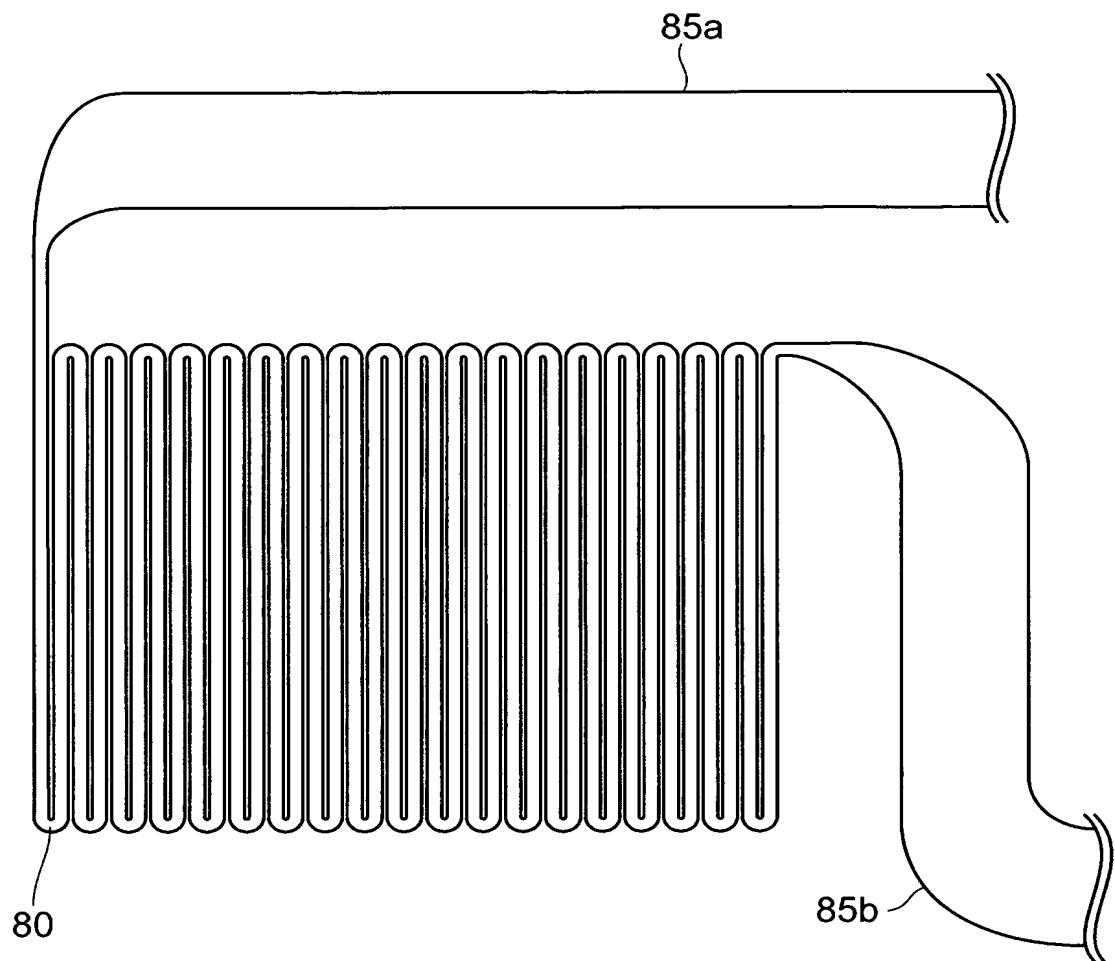
【図3】



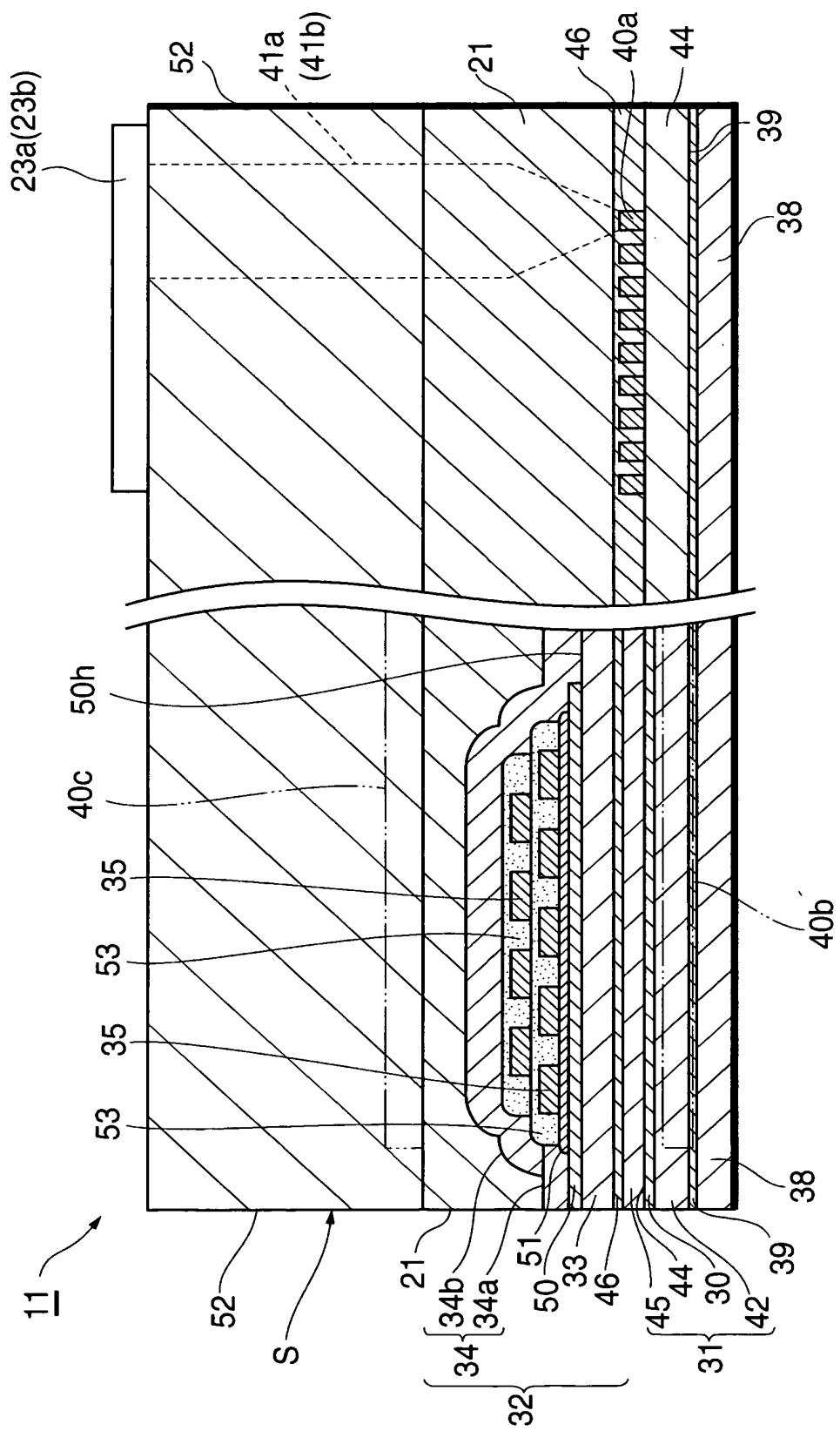
【図4】



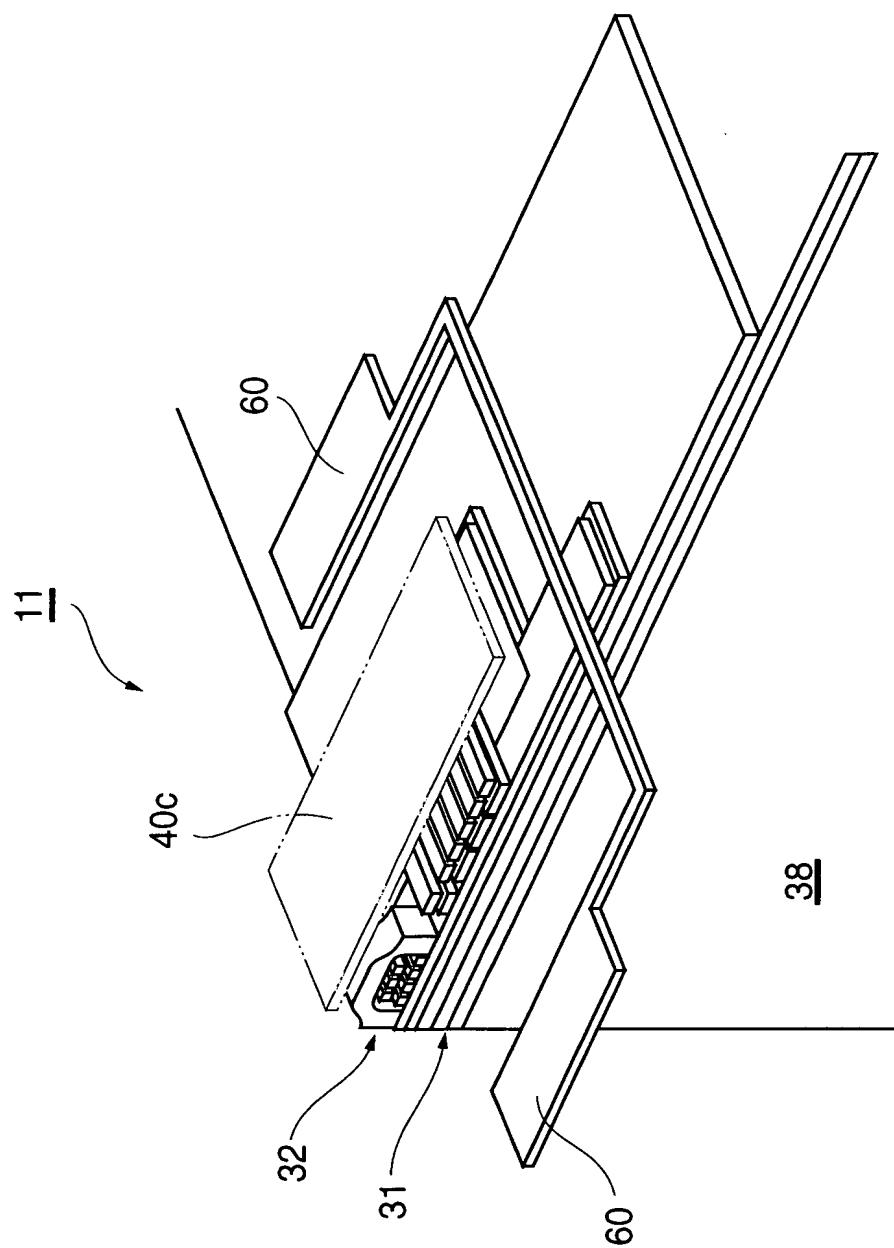
【図5】



【図6】



【図7】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 磁気抵抗効果素子の配線と誘導型電磁変換素子の配線との間におけるクロストークを防止することができるヘッドスライダ、ヘッドジンバルアセンブリ及びハードディスク装置を提供すること。

【解決手段】 本発明のヘッドスライダ13は、オーバーコート層21の表面の同一面内に、記録用電極パッド21a, 21b、再生用電極パッド22a, 22b及びヒータ用電極パッド23a, 23bが取り付けられている。ヒータ用電極パッド23a, 23bは、記録用電極パッド21a, 21b及び再生用電極パッド22a, 22bからなる群の両側に位置されている。これにより、ヒータ用の配線17aが、記録ヘッド部32の配線17bと再生ヘッド部31の配線17cとの間に位置することとなり、記録ヘッド部32の配線17bと再生ヘッド部31の配線17cとの間におけるクロストークを防止することができる。

【選択図】 図3

特願 2003-024621

出願人履歴情報

識別番号 [000003067]

1. 変更年月日 1990年 8月30日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都中央区日本橋1丁目13番1号
氏 名 ティーディーケイ株式会社

2. 変更年月日 2003年 6月27日
[変更理由] 名称変更
住 所 東京都中央区日本橋1丁目13番1号
氏 名 TDK株式会社